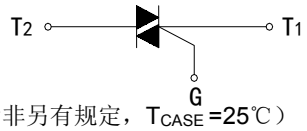
JST220 型三、四象限双向晶闸管芯片

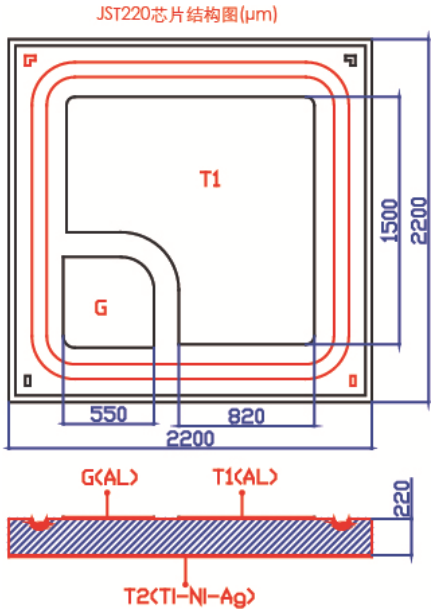
（芯片代码：CP308）

○ 芯片特征：单面台面结构，台面玻璃钝化工艺，背面三层金属电极。

○ 芯片尺寸：2.2mm×2.2mm

○ 可替换型号：BTA04/BTB04/BT136





○产品极限参数（封装成 TO-220 后，除非另有规定，T_{CASE} =25℃）

参数名称		符 号	数 值	单 位
结温范围		Tj	-40～125	℃
正向断态重复峰值电压		V_{DRM}	600/800	V
反向断态重复峰值电压		V_{RRM}	600/800	V
通态均方根电流 T_C=110℃		$I_{T(RMS)}$	4	A
通态浪涌电流	tp=20mS	I_{TSM}	40	A
	tp=16.7mS		41	
I^2t 值	tp=10mS	I^2t	8	A^2S
通态电流临界上升率 I_G=2×I_{GT},tr≤100ns, F=100Hz		dI/dt	50	A/uS
门极峰值电流	Tj=125℃	I_{GM}	4	A
门极平均功率	Tj=125℃	$P_{G(AV)}$	1	W

○ 产品电性能（封装成 TO-220 后，除非另有规定，T_{CASE} =25℃）

特性和测试条件	符 号	数 值	单 位
		T	
通态峰值电压 I_{TM}=8.5A,tp=380uS	V_{TM}	≤1.55	V
正向断态峰值电流 T_C=25℃	I_{DRM1}	≤5	uA
V_D=V_{DRM} T_C=125℃	I_{DRM2}	≤1	mA
反向断态峰值电流 T_C=25℃	I_{RRM1}	≤5	uA
V_R=V_{RRM} T_C=125℃	I_{RRM2}	≤1	mA
门极触发电压 V_D=12V, R_L=30Ω	V_{GT}	≤1.3	V
门极不触发电压 V_D=V_{DRM}, R_L=3.3KΩ, Tj=125℃	V_{GD}	≥0.2	V
门极触发电流 V_D=12V, R_L=30Ω	I_{GT}(Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ)	≤5	mA
	I_{GT} (Ⅳ)	≤10	
擎住电流 I_G= 1.2I_{GT}	I_L（Ⅰ-Ⅲ）	≤10	mA
	I_L（Ⅳ）	≤20	
	I_L（Ⅱ）	≤15	
维持电流 I_T=0.2A	I_H	≤10	mA
断态电压临界上升率 Tj=125℃ V_D=2/3V_{DRM}，门极开路	dV/dt	≥20	V/uS